

Влияние адсорбционных процессов на электрофизические свойства поверхностных слоев диэлектрических материалов

Veimer, Vladimir; Roninson, Aleksander Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 57-67 : ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Влияние влажности на поверхностную и объемную проводимость некоторых диэлектриков

Bender, Villem; Roninson, Aleksander; Silas, Aarne Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 79-88 : ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Влияние механических напряжений на поверхностную и объемную проводимости некоторых диэлектриков

Bender, Villem; Veimer, Vladimir; Mere, Arvo; Roninson, Aleksander; Silas, Aarne Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 65-72

Влияние отжига на свойства порошков Cds : Cu : Cl

Tuvike, Tiit; Palmre, Õie; Vallaste, Heikki; Päid, Imbi; Kuusmets, Eela; Petrov, P.I. Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 37-45

Влияние статических и динамических деформаций на электроизоляционные свойства резин

Bender, Villem; Veimer, Vladimir; Mere, Arvo Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 100-108

Гетероструктура CdS/TiO₂ как фотоанод электрохимической ячейки

Erm, Ants Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 66-83

Изменение интенсивности рентгенолюминесценции в процессе окрашивания содалитов

Ruus, Tõnu Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 31-37

Изменение параметров интегральных схем при анализе в растровом электронном микроскопе

Meiler, Boriss Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 85-92
https://www.ester.ee/record=b1296001*est

Измерение СВЧ фотопроводимости в материалах с высокой проводимостью

Vallaste, Heikki; Mellikov, Enn; Tuvike, Tiit; Palmre, Õie Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 57-63

Импульсно-плазменное легирование кремния сурьмой

Gavrilov, Aleksei; Katšurin, G.A. Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 15-28 : ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Импульсно-плазменный отжиг слоев кремния, имплантированных бором

Gavrilov, Aleksei; Katšurin, G.A. Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 3-13 : ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Индикатор качества противокоррозионной защиты

Veimer, Vladimir; Kurik, Lembit; Sinivee, Veljo Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 109-115

Ионные процессы в каркасных алюмосиликатах

Denks, Viktor; Mere, Arvo; Ruus, Tõnu Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 35-51 : ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Исследование миграции примеси меди в монокристаллах сульфида кадмия

Aarna, Heiti; Reiter, Erik Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 43-48

Исследование углов смачивания некоторых диэлектрических материалов

Veimer, Vladimir; Bender, Villem; Kurik, Lembit; Udris, V. Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 69-78 : ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Источник стабилизированного тока для многократного анодного окисления полупроводников

Gavrilov, Aleksei; Košelap, Andrei Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 94-99

Концентрационное уширение полос краевого излучения сульфида кадмия

Krustok, Jüri; Piibe, Toomas Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 22-28

Межфазное взаимодействие и ориентационные соотношения в системе никкель - арсенид галлия
Meiler, Boriss Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 3-12

Металлографическое исследование арсенида галлия с помощью электрохимического травления
Meiler, Boriss Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 13-21

Определение концентрационного профиля с помощью двух выпрямляющих контактов
Mankin, Romi; Paat, Aadu Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 29-33 :
ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Перераспределение вещества в поле внешних сил
Aarna, Heiti; Mankin, Romi; Reiter, Erik Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 39-41

Применение в ТПИ растворного электронного микроскопа в материаловедении
Paat, Aadu Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 79-84

Природа красной полосы люминесценции в CdS : Ag : Cl
Krustok, Jüri; Mädasson, Jaan; Altosaar, Mare Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 23-30

Процессы дефектообразования в примесном сульфиде кадмия
Mädasson, Jaan; Altosaar, Mare; Tomson, A.; Kuk, Peeter-Enn Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 57-65

Рекристаллизация порошков AlIBVI
Mellikov, Enn Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 46-56

Установка для измерения диэлектрических потерь порошковых материалов в широком интервале температур (80-600 K) и в условиях высокого вакуума
Mere, Arvo Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 53-56 : ил
https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Установка для многократного анодного окисления полупроводников
Gavrilov, Aleksei Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 73-78

Физико-химический анализ несовершенных полупроводниковых кристаллов
Kukk, Peeter-Enn Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 3-22

Фотолюминесценция химически пульверизованных пленок
Erm, Ants; Krunks, Malle; Mellikov, Enn Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 85-93

Центры рекомбинации в легированном серебром и хлором сульфиде кадмия
Krustok, Jüri; Mädasson, Jaan; Altosaar, Mare; Tomson, A.; Kuk, Peeter-Enn Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 29-36

Электрофизические свойства тонкопленочных барьеров шоттки на основе сульфида кадмия, изготовленного методом химической пульверизации
Krunk, Malle; Mellikov, Enn; Seilenthal, Mats Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1986 / с. 49-55